HYSOLAR G12

单晶硅片

N型-G12 / 210*210



弘元新材料(包头)有限公司

地址: 包头装备制造产业园区新规划区园区南路1号

网址: www.hoyuan.com 邮箱: sales@hoyuan.com

单晶硅片规格书



■关键参数

硅片型号	G12
导电类型	N型
掺杂元素	P (磷)
电阻率	0.4 ~ 1.6Ω • cm
少子寿命	≽800μs
氧含量	≤12ppma
碳含量	≤1ppma

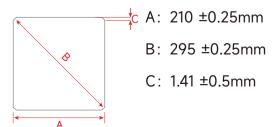
■材料性能

生长方式	CZ(直拉)法
结晶性	单晶
晶向	<100>±2°

■几何尺寸及表面性能

倒角边形状	直角
硅片边距	210±0.25mm
硅片对角线	295±0.25mm
厚度	130±10μm
TTV	≤25 µm
线痕	≤13 µm
翘曲度	≤40 µm
切割方式	金刚线切割
表面质量	干净,无油污、肥皂和胶水等残留物
崩边	深度<0.3mm,,长度<0.5 mm,不多于两处
裂纹/穿孔	目测不可见

G12 尺寸示意图:



质量管理体系与产品认证:

ISO 50001:2018 ISO 能源管理体系 ISO 9001:2015 ISO 质量管理体系 ISO 14001:2015 ISO 环境管理体系 ISO 45001:2018 ISO 职业健康与安全